

平成 28 年 9 月 28 日

委 員 各 位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体
光・電子デバイス第 162 委員会
委員長 岸野 克巳

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会
第 96 回委員総会・第 100 回研究会 開催案内
(100 回研究会 記念シンポジウム)

日時：平成 28 年 10 月 28 日（金）

委員総会：11:00 - 12:30

研究会(記念シンポジウム)：12:40 - 17:30

記念祝賀会・意見交換会：18:00 - 20:00

場所： 東京大学 駒場Ⅱキャンパス総合研究実験棟(An棟) (生産技術研究所)

委員総会：中セミナー室

研究会(記念シンポジウム)：コンベンションホール

記念祝賀会・意見交換会：コンベンションホール・ホワイエ

(京王井の頭線/駒場東大前駅西口から徒歩10分, 京王井の頭線/池ノ上駅から徒歩10分)

東京都目黒区駒場 4-6-1 総合研究実験棟(An 棟)

<https://www.iis.u-tokyo.ac.jp/ja/access/>

委員会

議 題：

- (1) 前回第 95 回委員総会議事要録承認について
- (2) 委員の異動について
- (3) 次回第 101 回研究会以降の研究会について
- (4) 日独西 WS について
- (5) その他

報告事項：

- (1) 開催報告：第 18 回結晶成長国際会議 (ICCGE-18)
- (2) 162 委員会 News 配信およびリーフレット送付について
- (3) 産学協力研究委員会特別事業の採択について
- (4) その他

100 回研究会記念シンポジウム

主 題： 「ワイドギャップ半導体が拓く高度環境・情報化社会」

開式 12:40-13:00

「委員長挨拶」

岸野 克巳（第 162 委員会・委員長）

「学振第 162 委員会の設立—その時代背景—」

高橋 清（第 162 委員会・元委員長）

特別講演 13:00-15:00

1. 「情報通信技術文明を拓いた光通信の発展」（13:00-13:40）
末松 安晴（日本学術振興会・産学協力総合連絡会議議長）
2. 「酸化物半導体：物質と応用のフロンティア」（13:40-14:20）
細野 秀雄（東京工業大学・教授）
3. 「社会が期待する窒化物半導体光・電子デバイス」（14:20-15:00）
天野 浩（名古屋大学・教授）

招待講演 15:30-17:30

4. 「InGaN 半導体レーザーの現状と今後の課題」（15:30-16:10）
長濱 慎一（日亜化学工業）
5. 「最新の環境対応車両用パワーエレクトロニクス技術と将来に向けたワイドバンドギャップ半導体の重要性」（16:10-16:50）
濱田 公守（トヨタ自動車）
6. 「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「次世代パワーエレクトロニクス」の取り組み」（16:50-17:30）
大森 達夫（内閣府）

記念祝賀会・意見交換会 18:00~20:00

<追記>

1. 10月28日の委員総会では、ご出席の回答をいただいた委員に昼食をご用意いたします。
2. 当日は、出席名簿にご署名・交通費の要否・空路陸路の種別等のご記入をお願いいたします。
ご記入の無い場合は、学振からのお支払ができませんので、よろしく願いいたします。
3. 祝賀会・意見交換会に出席される委員の方は、当日 3,000 円（講演者・招待者を除く）を申し受けますので、よろしく願いいたします。同伴者の方は 8,000 円となりますので予めご了承下さい。
4. 期間が短く大変恐縮ですが、準備の都合上、委員総会の出欠回答を 10月14日(金)までに web 回答シ

システムにてよろしくお願ひ申し上げます。